# Lucrarea nr.3: PROPRIETĂŢILE CONDUCTOARE ALE MATERIALFLOR

### Scopul lucrării:

Il constituie determinarea dependenței proprietăților conductoare ale materialelor de câmpurile termice și electromagnetice, precum și determinarea rezistivității materialelor.

### Conspectul platformei:

Conducţia electrică într-un material constă în apariţia unui flux dirijat de purtători mobili de sarcină la aplicarea unui câmp electric, E .

Proprietățile conductoare ale unui material izotrop sunt descrise cantitativ în domeniul liniar de coeficientul de rezistivitate electrică de volum  $\rho$  sau de mărimea inversă, conductivitatea electrică de volum  $\sigma=\rho^{-1}$ . Aceste mărimi sunt definite de forma locală a legii de conducție electrică:  $J=\sigma\cdot E$  respectiv  $E=\rho\cdot J$ .

În cazul metalelor purtătorii mobili de sarcină sunt electronii de conducție a căror concentrație este practic constantă, dependența rezistivității electrice de temperatură fiind determinată numai de constanta de relaxare.

La temperaturi scăzute:

T<<TD - temperatura Debye, este predominantă interacția cu fononii acustici rezultând o proporționalitate a rezistivității cu T5

La temperaturi ridicate:

T>>TD, acelaşi mecanism conduce la o proporţionalitate a rezistivităţii cu T.

Modelul benzilor energetice al corpului solid permite descrierea purtătorilor de sarcină. Descrierea purtătorilor de sarcină electrică se realizează pe baza modelului simplificat al benzilor energetice ale corpului solid. Conform acestui model, electronii unui atom ocupă diverse nivele energetice care pot fi grupe in benzi energetice:

- · banda de valență: electronii de valență sunt fixați în legături covalente.
- · banda de conducție: electronii de conducție sunt electroni liberi,
- · banda interzisă: electronii nu pot ocupa nivele energetice în interiorul acestor benzi.

În cazul materialelor conductoare, conducția curentului electric este asigurată de electronii de conducție, iar pentru cele semiconductoare și izolatoare – electronii de conducție și goluri.

## Desfasurarea lucrarii:

# Dependența de temperatură a proprietăților conductoare ale materialelor:

Cu ajutorul unui multimetru digital am masurat rezistența unei probe semiconductoare intrinseci de Germaniu si rezistența unei probe metalice de Ti/Pt .

Obtinem astfel datele din tabelul 3-1:

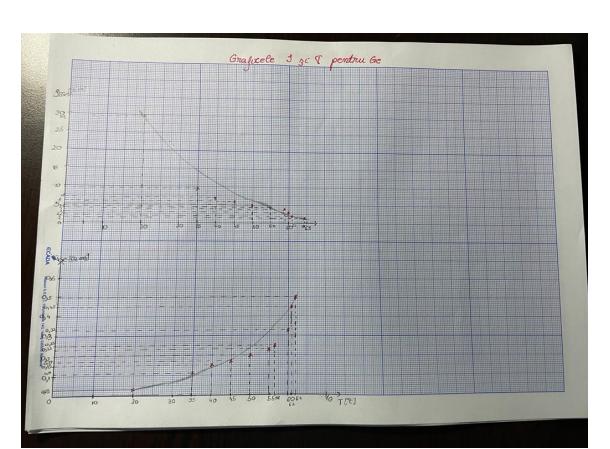
Tabelul 3-1.

Т		20	35	40	45	50	55	58	60	62	64
[°C]											
Valor	R <sub>Ge</sub> [	2900	950	680	600	500	440	400	300	220	200
i	$\Omega]$										
măsu	R <sub>TiPt</sub> [	119	131	134	136	137.5	140	142	143	144	145
rate	$\Omega$ ]										
	$ ho_{ ext{Ge}}\left[\Omega ight.$	29	9.5	6.8	6	5	4.4	4	3	2.2	2
H	m]										
Secți	$\sigma_{ ext{Ge}}\!(\Omega\cdot$	0.03	0.11	0.15	0.17	0.2	0.23	0.25	0.33	0.45	0.5
une	m) <sup>-1</sup>										
pentr	$ ho_{ ext{TiPt}}$ [	1309*	1441*	1474*	1496*	1512.5*		1562*	1573*	1584*	1595*
		$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$	$10^{-10}$
calcu	O <sub>TiPt</sub> (	7.64*	6.94*	6.78*	6.68*	6.61*	6.49*	6.4*	6.36*	6.31*	6.27*
le	Ω·m)-	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$	$10^{6}$
	1										

Din tabel se observa cum rezistivitatea germaniului scade invers proportional cu temperatura si conductivitatea acestuia creste direct proportional cu temperatura. Pentru TiPt este exact invers rezistivitatea creste, iar conductivitatea scade.

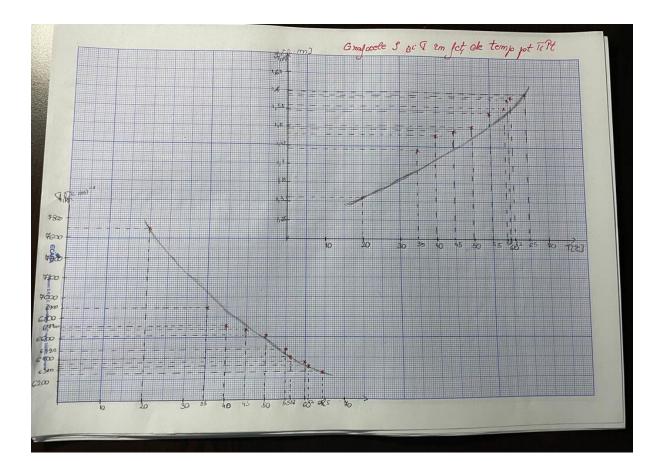
Cu ajutorul formulelor am calculat rezistivitatea si conductivitatea pentru cele 2 probe, cunoscand dimensiunile probelor:

Ge: L=10 mm = 0, 01 m = 10-2 m S = 10 x 10 mm2 = 0,000 1 m2 = 10-4 m2 TiPt: 1= 45 mm = 0,045 m = 45.10 m S = 0,  $65 \mu m \times 500 \mu m = 82$ ,  $5 \mu m^2 = 825 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2$ Dim formula  $R = S \frac{1}{5}$  se determina f: Jz RS iar  $8 = \frac{1}{3}$ Calculez 8 30 9 pentru rezestențele masurate ale Ge: SGe, = 2900 10 x = 23 [Rm] \ \( Ge, = \frac{1}{29} = 0.03 (Rm)^{-1} \) VGe 2 = 1 = 0,11 (2.m) SGC2 2 3.50 · 10 4 2 3,5 [Rm] Paes = 1 = 0,15 (2.m) JGe 3 = 680 · N-2= 6,8[Rm] 9 Ge 4 2 1 = 917 Cr. mi Sac 4 2 600 -10-2 2 6 [ scm3 VGe 5 = 1 = 0,2 C2. m) SGE 5 = 500 . 10 = 5 [ 12 m] TGEG = 1 = 0,23 (2.m) Seec = 440 . p = 4,4 [sm] SGEX = 400 · 10-2 = 4 [2m] (GEX = 1 = 0, 25 (2 m)) 9008 2 1 = 0,33 (r.m) SGE8 2 300 10-2 3 [rm] TGe9 = 1 = 9,45 (2.m) See 9 = 220 · 10 = 2,2 & rm3 I Ge 0 = 200 · N-2 = 2 [ 12 m] \ \ \( \text{GCD} = \frac{1}{2} = 0.5 \) ( \( \text{R} \) m) \



Calculate f gr f pentru resultant elemantate de f. f.

Size f =  $\frac{119 \cdot 825 \cdot 10^{-18}}{75 \cdot 10^{-2}} = 1309 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $\frac{131 \cdot 825^{11} \cdot 10^{-10}}{751} = 1441 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $134 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1444 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $136 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1496 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $137 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1512 \cdot 5 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $140 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1540 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $142 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1540 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $143 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1540 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $144 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1584 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $144 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1584 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $144 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1584 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ Size f =  $144 \cdot 11 \cdot 10^{-10} = 1584 \cdot 10^{-10} \sum_{R} \cdot m^{3}$ 



Calculete coeficientul de temperatura al retectorétation pentru re le 2 probe falas emol farmula:  $\alpha g = f \frac{\Delta f}{\Delta T}$ o pentru germanu (la 60 °C): S = 3 (2 m)  $\Delta f = (2,2-4) = -1,8$  2 m  $\Delta T = 62 - 58 = 4$  °C  $\alpha S_{de} = \frac{1}{3} \cdot \frac{-1,3}{4} = 0,33 \cdot (-0,45)$  grod = -0,148 grod = -0,148

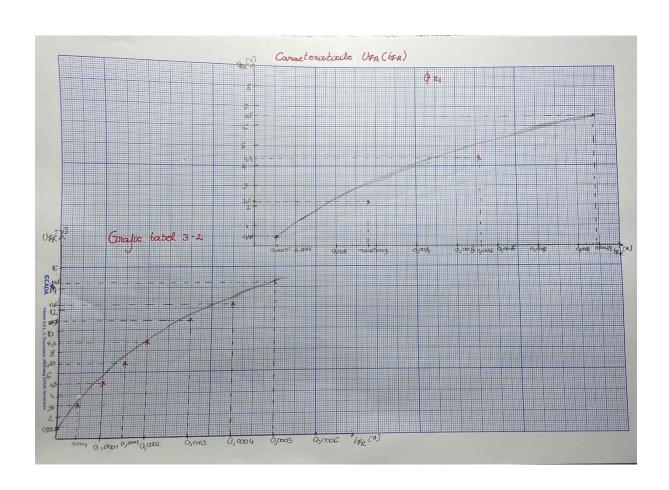
# Determinarea caracteristicii curent-tensiune pentru fotorezistență la întuneric:

Am conectat grupul FR-R la o sursă de tensiune de alimentare în intervalul 1V-15V, conform tabelului 3-2 și am măsurat tensiunea cu multimetrul digital HM 8113-3 – HAMEG pe fotorezistență.

Din tabel se observa cum curentul creste o data cu tensiunea.

**Tabelul 3-2.**  $R = 1 \text{ k}\Omega$ 

U [V]	1	3	5	7	9	11	13	15
$U_{FR}[V]$	0.99	2.96	4.9	6.85	8.8	10.7	12.6	14.5
$I_{TR} = \frac{\left(U - U_{FR}\right)}{\left(U - U_{FR}\right)}$	0.01	0.04	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5
FR R [mA]								



# Pentru taselul 3-2 am calculat ifr cu formula: IFR = <u>CU-UFR</u>) [MA]

IFR, = 1-0,99 = 0,01 [mA]

IFR2 = 3-2,96 = 0,04 2 m A]

14R3 = 5-4,9 = 0,1 [m]

iFR4 2 4-6,85 = 0, 15 [mA]

17R5 = 9-8,8 = 0,2 [mA]

17R62 11-10,7=93 [mA]

IFRY = 13 - 12,6 = 0,4 [mA]

IFR8 = 15 - 14,5 = 0,5 [mA]

Arm determinat resustența la Intuneric a fatorezistenței ca fund panta ocestui grafic: RFR = 26 512 · 108 SZ

Pentru tabelul 3-3 am calculat ixa cu farmula.

FR = CU-UFR) [mA]

· pentru (cr.) avem: · pentru (cr.) avem:

17R1 = 1-0,45 = 0,55[m] 17R1 = 1-0,88 = 0,12[m]

ifR2 = 5-2,2 = 2,8[mA] ifR2 = 5-4,3 = 0,7 [mA]

FR3 = 10 - 4,4 = 5,6 [m] iFR3 = 10 - 8,5 = 1,5 [m]

17R4 = 15-6,5 = 8,3 [m] i7R4 = 15 - 12,6 = 2,4 [m]

· pentru (cr3) avem:

17R3 = 18 - 14,3 = 0,7 [m] FRI = 1 - 0,98 = 0,02 [m]

4R2 = 5 - 4,8 = 0,2 [m/]

17R32 10-9,6=0,4 [mA]

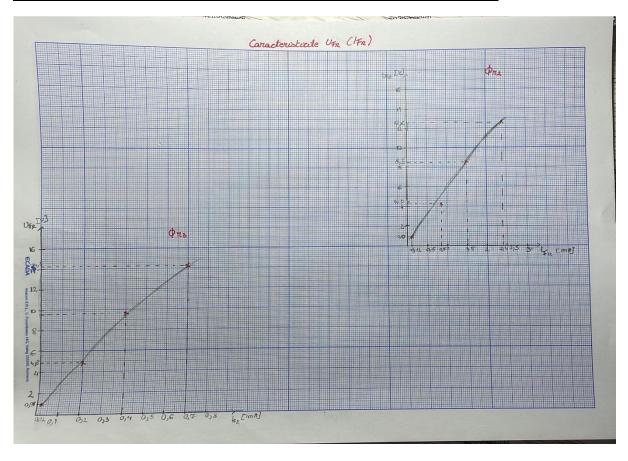
# Determinarea dependenței dintre rezistența fotorezistorului și fluxul luminos incident:

Pentru a determina această dependenţă se alimentează LED-ul la o tensiune de 10 V. Se poziţionează fotorezistorul la distanţa aproximativă r1=1cm de LED şi se măsoară tensiunea, cu multimetrul digital pe fotorezistenţă pentru patru valori ale tensiunii de alimentare a grupului FR-R. Se repeta măsurătorile pentru alte două poziţii ale fotorezistorului aflate la distanţele r2=10 cm şi r3=10 cm.

Prin pozitionarea fotorezistorului la diferite distante de sursa de luminoasa am observat variatia tensiunii si a curentului.

**Tabelul 3-3**  $R = 1 k\Omega$ 

Flux	U [ <b>V</b> ]	1	5	10	15
$\phi(\mathbf{r}_1)$	U <sub>FR</sub> [V]	0.45	2.2	4.4	6.5
	$I_{-D} = \frac{\left(U - U_{FR}\right)}{\left(U - U_{FR}\right)}$	0.55	2.8	5.6	8.5
	FR = R [mA]				
$\phi(\mathbf{r}_2)$	U <sub>FR</sub> [V]	0.88	4.3	8.5	12.6
	$I_{} = \frac{\left(U - U_{FR}\right)}{\left(U - U_{FR}\right)}$	0.12	0.7	1.5	2.4
	$^{1}FR = {R}$ [mA]				
$\phi(\mathbf{r}_3)$	U <sub>FR</sub> [V]	0.98	4.8	9.6	14.3
	$I_{TDD} = \frac{\left(U - U_{FR}\right)}{\left(U - U_{FR}\right)}$	0.02	0.2	0.4	0.7
	$^{1}FR = {R}$ [mA]				



#### Concluzie:

Lucrarea ne ajuta sa intelegem cum functioneaza conductia electrica intr-un material.Prin realizarea graficelor am observat cum variaza rezistivitatea si conductivitatea metalelor in functie de temperatura. Am invatat cum sa folosim un fotorezistor si pe ce principiu se bazeaza acesta si am determinat caracteristica curent-tensiune pentru fotorezistență la întuneric.

#### Intrebari:

1. Cum se explică faptul că, deși deplasarea purtătorilor mobili de sarcină se face sub acțiunea câmpului electric, mișcarea acestora nu este uniform accelerată, ci uniformă?

Deși deplasarea purtătorilor mobili de sarcină se face sub acțiunea câmpului electric, mișcarea acestora nu este uniform accelerată, ci uniformă deoarece depinde de materialul prin care trece curentul, a carui proprietati nu variaza in timp.

2. Cum se explică faptul că în general mobilitatea purtătorilor mobili de sarcină scade la creșterea temperaturii?

Mobilitatea acestor purtători scade în general la creșterea temperaturii după o lege practic liniară.

3. Definiți temperatura Debye.

Temperatura Debye reprezinta temperatura în care toate modurile de oscilație excitate sunt în solid.

4. Este justificată utilizarea unui coeficient de temperatură al conductivității pentru metale sau este mai potrivită introducerea unui coeficient de temperatură al rezistivității? De ce?

Consider ca este justificata utilizarea unui coeficient de temperatură al rezistivitatii pentru metale, deoarece acestea au proprietatea de a fi bune conductoare de electricitate, conducția curentului electric fiind asigurată de electronii de conducție. Este mai util sa observam cum creste rezistivitatea , marimea ce ne arata cat se opune materialul trecerii curentului electric.

5. Este justificată utilizarea unui coeficient de temperatură pentru materiale semiconductoare intrinseci? Să se deducă expresia lor analitică.

Consider ca este justificata utilizarea unui coeficient de temperatură pentru materialele semiconductoare intrinseci.

6. Precizia cu care se determină valoarea rezistenței fotorezistorului este mai bună dacă se măsoară tensiunea între bornele roşu-negru sau între bornele roşu-verde?

Precizia cu care se determină valoarea rezistenței fotorezistorului este mai bună dacă se măsoară tensiunea între bornele roșu-negru.

7. Să se precizeze rolul rezistorului montat în serie cu dioda electroluminiscentă.

Deoarece în polarizare directă dioda nu poate limita curentul, este necesară folosirea unui rezistor, conectat in serie cu dioda pentru a limita curentul prin aceasta.

8. După ce lege se modifică fluxul electromagnetic, emis de dioda electroluminiscentă și care cade pe fotorezistor, cu distanța dintre cele două componente?

Fluxul electromagnetic, emis de dioda electroluminiscentă variaza după o lege  $\frac{1}{r^2}$ .